## (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報(A)

昭57---212737

DInt. Cl.3

Ĕ,

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和57年(1982)12月27日

発明の数 2

審査請求 未請求

(全 9 頁)

H 01 J 9/233 29/38

7170-5C

**匈変換スクリーン及びその製造方法** 

31/50

ーマンストラート6

20特 願

昭57-98619

②出 願

昭57(1982)6月10日

優先権主張 32/1981年6月12日33オランダ

(NL) 308102839

⑫発 明者 テオ・ヨハン・アウグスト・ポ

プマ

オランダ国5621シーティー・ア インドーフエン・ピーター・ゼ

ーマンストラート6

勿発 明 者

ゲルハルダス・アルベルタス・

テ・ラー

オランダ国5621シーティー・ア

インドーフエン・ピーター・ゼ

仰発 明 者 アドリナス・テニウス・ヴィン

> オランダ国5621シーティー・ア インドーフエン・ピーター・ゼ

ーマンストラート6

⑪出 願 人 エヌ・ベー・フィリップス・フ

ルーイランペンフアブリケン オランダ国アインドーフエン・ ビーター・ゼーマンストラート

個代 理 人 弁理士 杉村暁秀 外1名

細

変換スクリーン及びその製造方 1. 発明の名称

#### 2. 特許請求の範囲

- キャリア上に変換材料を駐職させて変換ス クリーンを製造するに当り、変換材料の粉末 をガス流(18)に築せて該変換材料の粉末 が溶触される溶触空間を通過するように噴射 して該変換材料の溶盤温度より低い温度にあ る削記キャリア上に入射させることを特徴と する変換スクリーンの製造方法。
- 熱することを特徴とする特許請求の範囲1記 収の変換スクリーンの製造方法。
- 前記粉末は堆積されるべき変換層の厚さの **最大でも0.5倍のほぼ均一な粒度を有する粒** 子を以つて構成することを特徴とする特許的 水の範囲1または2記蔵の変換スクリーンの 製造方法。
- 前記粉末の粒度及び流速、前記溶酸空間の

体積及び温度、及び該溶融空間(7)とキャ リア(19)との間の距離を、密な均質層を 形成するため、相互に最適値とすることを特 敬とする特許請求の範囲1~3のいずれかー つに記載の変換スクリーンの製造方法。

- 前記変換材料の加熱及び駐機処理を良好な 状態とされるべき密閉空間(1)中で行なう ことを特徴とする特許請求の範囲1~4のい ずれか一つに記載の変換スクリーンの製造方
- 堆積処理期間中、前配粉末用ノメル(11) と前記キャリア(18)との間で相対移動を 行なわせることを特徴とする特許請求の範囲 1~6のいずれか一つに記載の変換スクリー ンの製造方法。
- 7. キャリア材料を啓触された変換材料の流れ 中に連続的または間欠的に供給することが出 来るようになしたことを特徴とする好許請求 の範囲1~8のいずれか一つに記載の変換ス クリーンの製造方法。

- 8. 前記キャリアの前記変換層が堆積される側 に表面構造を備えることを特徴とする特許請 求の範囲 1 ~ 7 のいずれか一つに記載の変換 スクリーンの製造方法。
- 9. 前記特許請求の範囲1~8のいずれか一つの方法によつて製造されかつ密度の改良されている変換スクリーン。
- 10. キャリア(30)、発光層(36)及び保護順(38)をもつたX線増倍スクリーンとして構成したことを特徴とする特許請求の範囲 8 記載の変換スクリーン。
- 11 キャリアと、入射放射によつて生ぜしめられた 健位像を形成出来る層の形態にある変換層とを具えることを特徴とする特許請求の範囲 9 記載の変換スクリーン。
- 12 特許請求の範囲9に記載したような変換スクリーン(48)を具えるX線イメージ増強管。
- 18. 出射スクリーン(58)をキャリアとして 光ファイバー窓(46)をもつた特許請求の

8

### 8. 発明の詳細な説明

本発明は変換材料をキャリア上に堆積して変換スクリーンを製造する方法、該方法により製造された変換スクリーン及び斯様なスクリーンを具える製品に関する。

この種のヌクリーンにおいては、変換層の放射

範囲 8 に記載したような変換スクリーンとしたことを特徴とする特許請求の範囲 1 2 記載の X 級イメージ増強管。

- 14 内部の螢光スクリーンを特許請求の範囲9 に記載したような変換スクリーンとしたことを特徴とする陰極線管。
- 15. 像形成入射スクリーンを特許請求の範囲の に記載したような変換スクリーンとしたこと を特徴とする操像管。
- 16. 橙光スクリーンを具える桜光ランプの壁部分を特許請求の範囲 9 に記載したような変換スクリーンとしたことを特徴とする螢光ランブ。
- 17. 検出スクリーンを特許請求の範囲9 に記載したような変換スクリーンとし、その変換層の厚さを500 μm 以上としたことを特徴とする高エネルギー電磁放射または微粒子放射検出装備。

4

吸収率が高いと情報をもつた放射のほとんどが吸 収されよつてこれが検出しようとする信号または 像に寄与出来るので、変換層の放射吸収は大きい ことが好ましい。吸収が大であるためには、特に、 通常は材料の原子番号によつて決まる、変換され るべき放射に対する当該材料の吸収係数及び変換 材料の層の厚さが重要な要因となる。第1の要因 である吸収係数は使用材料の選択範囲を制限し、 第2の要因である薩摩は、この層の幾何的摩さが 増大するとそれによつて常にスクリーンの解像度 が損なわれるので、材料の変換層の取り得る密度 によつて実質的に定まる。これがため、変換層の 厚さは最大吸収と最適解像胜との調和を考えて決 められるものである。吸収が大であると、例えば、 医療診断装置におけるX線検出スクリーンの場合 には、患者への放射線量を制限するので、この点 から吸収の大きいことが重要である。しかしなが ら、層が海いと、吸収前に入射放射が横方向に散 乱してしまいしかも特にこの層中に発生した放射 又は運荷キャリアが散乱するため解像運が損なわ

れる。これがため、変換に対する吸収係数が高くかつ密度が大であつて幾何学的層厚は薄くし得るようになし得る変換材料の層を得る試みがなされている。このような考えに基づき、例えば、米国特許 3 4 7 5 4 1 1 に配載されているように、例えば緩単結晶の発光スクリーンを製造する試みがなされている。しかしながら、この方法は大規模な使用には適していない。

7

無2の方法は、米国特許第3825763号に開示されているように、発光材料を蒸精する方法である。この方法によれば理論的協密度になった発生によれば確実になった発光膜が得られる。さらに、この解の中でもつた発光膜が得られる。さらに、この解の中ではとなさせしめる程十分な状態にある。例えば、約250μmに至る厚さを有する、このタイプの解を整治するには相当高になったので換材料が、ので表着するには相が行なわれる雰囲気が開発を起するという理由のため、基着には不適当である。

本発明の目的は、品質の低下を来すことなくか つキャリア並びに変換材料の選択自由度を高く保 ちながら、相当厚い層厚のスクリーンまで迅速か つ安価に製造出来るようにした変換スクリーンの 製造方法を提供することにある。

この目的の達成を図るため、本発明によれば、

る処理は、米国特許第 3 8 8 6 7 6 3 号に 開示されているように、ひび入り ( クラックルド:

crackled)構造を形成しこのひび中に光反射材料または光吸収材料を充填することである。キャリアに対する接着を良好にすることは、風射中に変換層に生じる熱及びイメージ増強管の出射スクリーン及び陰極線管の表示スクリーンの場合には、例えば、許容放射負荷を制限するような熱を消散させるために重要なことである。

従来、例えば発光層を堆積するには2通りの方法が用いられており、第1の方法では発光材料をキャリアに接着させて互いに接着するために一般に結合剤を必要とする発光材料の懸濁液を沈れる。特に結合剤を使用するため、これら発光機の密度は比較的小さく、例えば、最大でも発光材料の理論的高密度の約50%である。これがため、現想的な放射吸収を得るため、これら簡を比較的厚くし、例えば、X線イメージ増強の入射スクリーンやX線増強スクリーンの場合には500μm

. 8

変換材料の粉末をガス流に乗せて該変換材料の粉末が溶触される溶触空間を通過するように噴射して該変換材料の溶触温度より低い温度にある前記 キャリア上に入射させることを特徴とする。

本発明方法による場合には、粉末粒子の大きさ、流速、溶融空間の体模及び温度を互いに最適値に選定することにより、従来よりも短時間で異なる
厚みの高品質層を堆積出来る。この脳のキャリアに対する接着及びこの層自体における相互接着は非常に強いので、この層に対し他の機械的処理例えば研削、研磨又はエッチング等の処理を行ない得る。相互接着が優れているので、変換材料の自己支持層を形成出来るようにキャリアを除去することも可能である。

溶船空間に対しては、好ましくは、堆積されるべき物質を汚染してしまうような燃焼生成物を局部的に生じさせることなく、例えば 1 0 0 0 0 ℃の温度に達し得るプラズマ放電を使用する。温度が高いため、材料粒子は著しく迅速に熔触し、特に低速を速くすると、極めて短時間内にこれらを

本発明の好適実施例では、発光スクリーン用の キャリアを、ガラス・ファイバーのコアの発光臓 側をエッチングにより部分的に除去した光ファイ バー・ブレートを以つて構成するのがよい。

従来公知の堆積法と比較し、本発明による方法は、キャリア中の解の横方向寸法が相当狭くても、 これら海に好ましい状態に充塡することが出来る。 本発明による方法によつて製造される放射変換

11

内に使用されている金属裏打ちをおそらくは同一 方法で稠密登光層上に直接堆慣出来るという利益 を奏する。催子顕微鏡とかオシロスコープ管のよ 5 な 特定の応用に対する陰極線管及びイメージ増 強管の出射スクリーンの場合には、1局所負荷が一 層高いことが許されるので、層厚を低減すると共 に 充 填密度 を 高くしか つ 熱 伝 溝の 改 番 が 図 れる と いう点が好ましい。後者の特性のため、これらス クリーン質谱分析装置のような基本粒子の検出側 定器機に使用して有益であり、その場合、層の自 己支持特性を使用することにより感度を高めかつ ローバスト(robust)なスクリーンとして交換可 能なスクリーンが使用可能となる。例えばX線検 出器の場合には、光導電特性を有する放射変換層 を使用出来、その場合、この層をセレン・スクリ ーンの形態とし、このスクリーン上に入射像情報 を有するX線ビームによつて形成された像を貫子 写真処理における電荷パターンによつて普込像に 変換出来る。或いはこの変換層を入射像情報を有 する放射ビームによつて生じた電位パターン例え スクリーンを多くの生産品、例えば、X線診断装 憧 に 使 用 されるような X 線 増強 スクリーンとして 用いることが出来る。その場合には、これらスク リーンは、 像情報を有する X 線ピームをこれらス クリーンの後方に配耀したフイルム・フォイルが 特に感応する放射へと変換するが、像品質の低下 は最小限度に押えることが出来る。イメージ増強 質においては、これらスクリーンを入射スクリー ン並びに出射スクリーンとして使用し得るが、そ の場合にも、既に説明した2つの機能において従 来のスクリーンよりも優れた利益を発し得る。例 えば、米国特許4179100号に記載されてい るようなX線検出器では、所要に応じて、構成さ れたキャリアをもつた本発明によるスクリーンを 使用してさらに明確に系列分けされた個々の検出 器業子を形成出来る。

本発明によるスクリーンを陰極線管にも使用し 大量生産に供し得る。その場合、著しく速くてか つ安定な処埋工程を使用し得、その場合陰極線管 内での螢光粒子の脱離もなくしかも通常陰極線管

12

ぱモニタ表示するためのビデオ信号に変換するよ ちになした機像管にも使用出来る。

以下、図面により本発明の実施例につき説明する。

第1図はプラズマ・スプレイによつて本発明に よる変換スクリーン製造用装置を示す。この目的 のため、この妄聞ではハウジング1内にプラズム 放電アークすなわちプラズマ・アーク1を発生さ せるための第1及び第2電極3及び5を備えてお り、これら運極間に電圧源9を接続してある。粉 末変換材料を、容器13からガス圧容器15から のガス硫と一緒に、混合室16へ供給する。この ガスと粉末変換材料との混合作18をノズル11 を介してプラズマ放催アーク1を通るように噴射 する。谷器13は粗い変換材料から粉末材料を作 り出すための手段を備えることが出来、好ましく はこの粉末材料の粒度が比較的狭い腹界内にある ものを使用する。非常に細かな粒状粉末を使用し ようとする場合には、╓れ粉末を追加してファン・ テル・ワールヌカの作用で粒子が一体となつて塊

とならないようにするのが有益である。この目的 。のため、容器19を備える。この硫れ粉末として 例えば AlgOg または SiOg を使用することが出来 こる。また、この塊まりとなるのを防止するため帯 観粒子を使用することが出来る。 粉末とガスとの 混合硫18を、プラズマ・アークの方向に、例え は、100kPaの圧力で相当速い速度で噴霧する。 このファズマ・アークの後側に調整可能な距離だ け雑してキャリア19を配増し、このキャリア 18を図に略図的に示すよりに褶動部材21に取 り付け、この指動部材をレール23上を移動出来 ように構成する。プラズマ・アークからは離れた 側のレールの一端に遮蔽部材24を備え、この遮 厳部材の後側にフイルタ25及びポンプ27から 成る排出装置を配置する。図示の装置は、例えば、 滅圧作動を可能とならじめるため 密閉室タイプで あり、この装置については米陶特許第3839618 号明細御に詳細に記破されている。或いは又、堆 徴しようとする物質や形成しようとする層に対す る嬰件に応じて、開放装置またはキャリアを送り

1 6

職、材料推構処理中のキャリア偏度及び閉球成立れたまたは閉成されていない作業空間中の新聞の気ののでは、できたのではなく、個々のパラメータは原外の保証ではなく、例えば、友子の加加をではなく、例えば、カータののはないではなって、が、スママ・アークのはないではなって、対対の流速をである。材料を予めていることの論である。

病常はキャリアの温度を潤明温度と同一温度になし得るが、堆積された著しく無い材料によりキャリアが加強される。これがため、所受に応じて処理期間中キャリアを冷却するかキャリアをヒートンンクに収賞して過熱を防止するようにするのがよい。例えばALのような特定のキャリア材料の場合には、キャリア上に変換材料を堆積させる前にこのキャリアを加熱しておくようにするのがよい。この目的のため、キャリアをヒータに取り付けることが出来る。

材料能によつて運ばれる材料粒子はこれがブラズマ放電アークを通過する際に加熱され、よってこれら粒子は材料の液体小腐となってアークを超れてキャリアに堆積される。好適均質を研るには、好ましくは比較的均一な大きのの程度に が来を使用し、また層厚を開するのが良い。 おり粒度の小さい粉末を使用するのが良い。 はより粒度の構造はさらに材料能の旋速、放電アークの温度、放電アークとキャリアとの間の距

. 16 :

この方法により金銭層を単樹させると、軽固に 接着しかつ稠密な層が得られることは知られてい る。これがため、この方法は、通常、金銭のよう な異材から成る防蝕性層を集潰するために広く使 用されている。

好適なものである。

また、変換材料も非常に沢山の材料中から選択する。度々X酸イメージ増強スクリーンに使用される材料である CaWO4 を有するルミネツセント・スクリーンに対して好適な結果が得られた。この場合、この材料を通例はコロイド溶液から結合剤と一緒に駐債させる。従つて、既知の層の発光材料の密度は埋締的高密度の最大でも約50%である。

渡2回はキャリア30、常電防止層32、反射 層34、骶光層36及び遮蔽層38から成る斯様 なスクリーンを略図的に示す線図である。既知のイメージ増យスクリーンに使用される例えば CoWO4と同一の発光材料を使用する場合には、光境密度を高めると層厚を約½に低波し得るが、その場合でも所望の最小吸収特性を維持出来る。他方、同じ厚さの層であると吸収が実質的に高をして、の適用のでは、本層点めることに重きを耐く、この適用例では、本

- 19

誘導された材料又は CsI(Na.) をこれらスクリーン

用発光材料として使用出来る。層が稠密構造であ るため、CsI(Na)の吸湿性はほとんど問題がない。 本発明によるスクリーンの譲る適用例としてイ メージ増強費、特化X線イメージ増強質がある。 果る図に示すX線イメージ増強質は金属ハウシン グ40を具え、このハウジングは厚さが測えば約 2 5 0 μm のチタンから成りかつ支持リング 4 4 を介してハウジングのジャケット形に結合されて いる入射器42と、例えば平凹光ファイバープレ - トで形成された出射器 4 fi とを有している。こ **のハウジングの内部に、キャリア50、ルミネツ** センス層すなわち発光膜52及び光電陰値34を もつた発光スクリーン48と、電子光学システム 5 flとを有していて、この棋子光学システムによ つて、光電陰優から反射される電子の像を、この 場合光ファイバー窓46の凹所に直接配置されて いてかつ出射スクリーンとして作用する発光スク リーン 5 8 上に形成する。このような X 觮イメー 発明による発光層の厚さを、例えば、約200 畑 とするが、通常の簾では厚さは例えば 5 0 0 um である。この種のイメージ増強スクリーンは所雇 機影装備及び遊視装備のようなプッキー格子を具 えるX線診断装備に広く使用されている。本発明 によるX級イメージ増強スクリーンが一層高い解 像度を有するという事実に加えて、本発明方法に よれば相当安価にこれを製造することが出来ると 共に、キャリア及びもし存在するならは労運防止 屬の材料の選択の自由度が大となる。本発明によ るスクリーンの解像度を、米国特許第8961182 号明細書に開示されているようなひび入り糊造 (crackled structure)を使用することによつて 髙めて横方向の散乱を低震させることが出来る。 この方法が最適とし得る埋由は、発光材料がキャ リアに特に良好に接着するからである。ひびの頻 **度を失める構造を備えるキャリアを使用すること** が出来る。通常は、好適なひび入り構造を得るた めに数個の区分した層で堆積する必要はない。 CaWO4 の外に、Y2O8(Eu), ZnS 及びこれらから

20

4 2 1 3 0 5 5 号明細書に詳細に述べられており、この層は例之ば CsI(TL) を真空蒸潜して形成し、特にその層にひび入り溝造が形成されているため解像度が高い。 CsI を蒸消させる場合には、熱後処理が必要となることを考慮すると、この方法はこのイメージ均衡管の出別スクリーンには簡単に使用出来ない。この目的のために使用されるべき発光材料の選択の循環は少ない。その埋由は入射電子の速度が例えば3 0 kV にまで高速となると、スクリーンに続け現象が生ずるおそれがあるからである

このような事情で、度々、出射スクリーン用発 光材料として 2nS を使用する必要が生じ、その場合この材料を懸燭液から沈輝によつて堆積させる。 発光材料として 2nS を利用する斯様な 資に本発明: による方法によつて製造された出財務を使用する 場合には、材料が密に堆掛(又は機順)するため 解像度又は感度はもとより、光麻密度が高いため 熱伝典が高く、従つて、耐熱性に関して実質的な 改良が得られる。既に説明したように、 Cal スク

ジ増強質の発光層52mついては米国特許第

リーンは何ら然後処理を必要としないので、例えば Cs I (Na) を本発明による出射スクリーン用に使用出来、よつて、吸収従つて効率及びスクリーンでの解像でが一層がくなる。再び発光材料の層にひび入り構造を設け、よつて解像度を一層向上させることが出来る。これらクラックすなわちひびに好適物間を光順すると、層の盾内の熱伝道特性を改良することが出来る。

特に好商な実施例においては、光ファイバー出 対窓のファイバー体体をひび入り構造にの光ファイバーなっとして利用する。これがおけられる側のアファイバーのコアを、光度が設けられる側のファイバーのコアを、で変された時に発光が成立された時に発光がない。 なったで着色するの様のはないで、ないするの被像材料が必要のが、といばないにないで、ないでするのがで、ないでするのがで、ないでするのがで、ないでするのが、ことに低速であることが出来るので、が出ていている。発光材料は複めて、接端するので、が使にじファイバーの被機端に単

. 23

上述においては、 X 棟とか電子放射とかの放射を変換層で(可視) 光に変換し、これら層を通常発光層または登光層と称する実施例につき説明した。 単子放射を光に変換する変換層は度々例えばテレビジョン表示官、オンロスコープ育等々に使

行された材料を研削して除去出来、よつて発光材料がファイバーの海中にのみ存在するようにする と共にひび入り構造を設ける必要がないようにすることが出来る。選4図からも明らかなように、 発光材料とファイバーの鑑面との間の米の透過を この端面を凹値形状とすることによつて高める。

既に説明した通り、米園特許第3961182 号及び組4213055号に記載されているX線

24

用される。これまでは、この目的に対し本発明によるスクリーンの形成を排除するような制限もなかつた。特に、例えば、高エネルギー酸酸放射、電子、イオン又は他の悪な的な粒子の検出を行なる。である。従つて、層が無機するおおでは小さく、この層が再発には、この汚染を何ら危険を伴うことなくこの層から除去出来る。

別のタイプの変換層は、例えば、X線、選子放射等の入射放射を変換層の表の一例としてで変換をでいる。その一例としてのをがある。とは、Y線ではなって像を形成のでは、Oの電子ではなっているでは、大力では、対しては、対しては、対して、というなどでは、できる。とのでは、不発明によるスクリーンは高密度によりでは、不発明によりでは、不見ないるに、不見ないる。というないには、大力によりでは、不見いるスクリーンは高密度によりでは、不見いるに変換をは、ののに、不見いるスクリーンは高密度になっては、不見いるにある。とは、Mana をは、不見いるに、Mana をは、Mana は、Mana は、Ma

本発明による方法を溶融空間としてプラズマ・アークを用いる場合につき説明したが、アセチレン協装置によつて発生させた焰アークによつても良好な結果を得ることが出来る。この方法によれば、光反射性アルミニウムキャリア上の CaWO。の変換層を、この変換層をキャリアに結合することに何ら問題を生ずることなく、得ることが出来た。勿論、このようなスクリーンをもつた装置の光効

27 .

2 7 … ポンプ、 3 2 … 帯電防止層、

84…反射層、36…發光層、88…遮蔽層、

- 4 0 … 金属ハウジング、 4 2 … 入射窓、
- 4 4 … 支持リング、 4 6 … 出射器、
- 4 8 . 5 8 … 発 光 ス ク リ ー ン 、 5 2 … 発 光 層 、
- 5 4 … 光麗陰極、 5 6 … 電子光学システム、
- 6 0 … 光ファイバー、 6 2 …コア、 6 4 …空間、
- 6 6 …端面。6 8 …被搜。
- 70…(被獲の)一部分。

特 許 出 顧 人 エヌ・ペー・フィリップス・ フルーイランペンフアプリケン

问 弁理士 杉 村 與



本発明は上述した実施例にのみ限定されるものごでなく、多くの変形または変更を行ない得ること 明らかである。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はプラズマ・アークを用いて本発明に よる方法を実施するための装置を示す略線図、

第 2 図は本発明による X 線像増倍スクリーンを 示す断面図、

第8図は本発明によるX歳像増倍資を示す線図、 第4図はルミネツセンス材料が部分的に元項された本発明によるスクリーンのガラスファイバを 示す線図である。

1 …ハウシング、3 … 消 1 電値、 5 … 第 2 電極 7 … プラズマ放電アーク、 8 … 電圧源、

11…ノメル、18,17…容器、

1 5 … ガス圧容器、 1 6 … 混合室、1 8 … ガス流、

1 9 . 8 0 . 5 0 … キャリア、2 1 … 摺 勧 心 材 、

2 3 … レール、 2 4 … 遮蔽部材、 2 5 … フイルタ

. 28

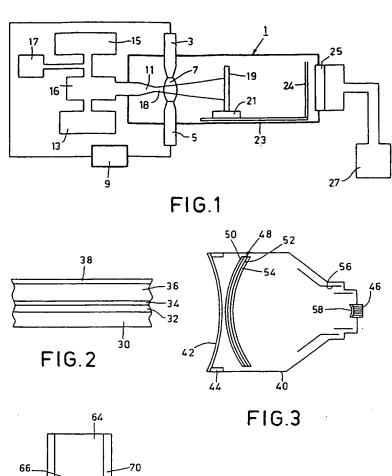


FIG.4

<u>60</u>

THIS PAGE BLANK (USPTO)